








	<h2>SI7846DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7846DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7846DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 64832 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7846DP-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	64832 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

SI7846DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7846DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7846DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7846DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7846SAC VISHAY SI7846SAC VISHAY</p>	 <p>SI7846DP VISHAY SI7846DP VISHAY</p>	 <p>SI7846DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7846DP-TI VISHAY SI7846DP-TI VISHAY</p>
 <p>SI7846DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7844DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7846DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7846DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7820DN-T1-E3	 SI7820DN-T1-GE3	 SI7820DN-T1-GE3	 SI7840BDP	 SI7840BDP-T1-E3
 SI7840BDP-T1-E3	 SI7840BDP-T1-GE3	 SI7840BDP-T1-GE3	 SI7840DP	 SI7840DP-T1
 SI7840DP-T1-E3	 SI7840DP-T1-GE3	 SI7840DP-T1-GE3	 SI7842DP	 SI7842DP-T1-E3
 SI7842DP-T1-E3	 SI7842DP-T1-GE3	 SI7842DP-T1-GE3	 SI7844DP	 SI7844DP-T1
 SI7844DP-T1-E3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7846DP
 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-TI	 SI7846SAC
 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848DP
 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3
 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP	 SI7852ADP-T1-E3
 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP	 SI7852DP-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited